# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representation of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

09-054973

(43)Date of publication of application: 25,02.1997

(51)Int.CI

G11B 7/135

(21)Application number : **08-049781** 

(22)Date of filing:

07.03.1996

(71)Applicant : NEC CORP (72)Inventor: KATAYAMA RYUICHI

(30)Priority

Priority number: 07137675

Priority date: 05.06.1995

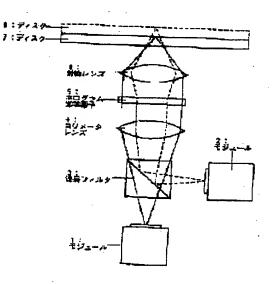
Priority country: JP

### (54) OPTICAL HEAD DEVICE

#### (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To perform a recording and a reproducing with a high S/N with respect to two kinds of thicknesses of disks even without making the output of a semiconductor laser excessively large.

SOLUTION: A semiconductor laser having the wavelength of 635nm and a light receiving element are incorporated in a module 1 and a semiconductor laser having the wavelength of 785nm and a light receiving element are incorporated in a module 2. The exit light from the module 1 is transmitted through a wavelength filter 3 to be made to be parallel beams in a collimator lens 4 and are transmitted through a hologram optical element 5 to be condensed on a disk 7 by an objective lens 6. The reflected light traces a reverse optical path to be detected by the light receiving element in the module 1. The exit light from the module 2 is reflected by the wavelength filter 3 to be made to be parallel beams in the collimator lens 4 and a minus 1-st order diffracted light by a hologram optical element 5 is made



incident on the objective lens 6 as a divergent light to be condensed on a disk 8. The reflected light traces a reverse optical path to be detected by the light receiving element in the module 2.

#### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

07.03.1996

[Date of sending the examiner's decision of

28.07.1998

rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3047351

[Date of registration] 24.03.2000
[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right] 24.03.2000

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

### (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-54973

(43)公開日 平成9年(1997)2月25日

(51) Int.Cl.6

G11B 7/135

識別記号

庁内整理番号

FI

技術表示簡所

G11B 7/135

Z

審査請求 有 請求項の数10 OL (全 17 頁)

(21)出願番号

特願平8-49781

(22)出顧日

平成8年(1996)3月7日

(31)優先権主張番号

特願平7-137675

(32)優先日

平7 (1995) 6月5日

(33)優先権主張国

日本 (JP)

(71)出願人 000004237

日本電気株式会社

東京都港区芝五丁目7番1号

(72)発明者 片山 龍一

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株

式会社内

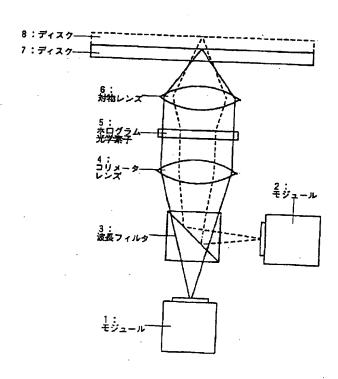
(74)代理人 弁理士 尾身 祐助

#### (54) 【発明の名称】 光ヘッド装置

#### (57)【要約】

【目的】 半導体レーザの出力を過度に大きくしなくても、2種の厚さのディスクに対し、記録・再生を高いS/Nで行うことができるようにする。

【構成】 モジュール1内には波長635nmの半導体レーザと受光素子が内蔵され、モジュール2内には波長785nmの半導体レーザと受光素子が内蔵されている。モジュール1からの出射光は波長フィルタ3を透過しコリメータレンズ4で平行光化され、ホログラム光学素子5を透過し、対物レンズ6によりディスク7上に集光される。その反射光は逆の光路を辿りモジュール1内の受光素子により検出される。モジュール2からの出射光は波長フィルタ3により反射されコリメータレンズ4で平行光化され、ホログラム光学素子5による-1次回折光は発散光として対物レンズ6に入射しディスク8上に集光される。その反射光は逆の光路を辿りモジュール2内の受光素子により検出される。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 第一の波長で発振する第一の半導体レー ザと、第二の波長で発振する第二の半導体レーザと、前 記第一の半導体レーザからの出射光と前記第二の半導体 レーザからの出射光を合波することのできる光合波手段 と、それぞれの半導体レーザの出射光を第一または第二 の光記録媒体に導くホログラム光学素子および対物レン ズと、前記光合波手段の前記ホログラム光学素子と対向 する側に設けられた、前記第一および第二の半導体レー ザの出射光の光記録媒体からの反射光を受光する光検出 10 部と、を備え、前記ホログラム光学素子による前記第一 の半導体レーザの透過光および前記第二の半導体レーザ の-1次回折光を用いることにより、あるいは、前記ホ ログラム光学素子による前記第一の半導体レーザの+1 次回折光および前記第二の半導体レーザの透過光を用い ることにより、前記第一の半導体レーザの出射光を第一 の光記録媒体に導き、前記第二の半導体レーザの出射光 を前記第一の光記録媒体より厚い第二の光記録媒体に導 き、それぞれの光記録媒体に対して再生または再生およ び記録を行うことを特徴とする光ヘッド装置。

【請求項2】 前記対物レンズは、前記ホログラム光学素子からの透過光が該透過光が導かれる光記録媒体の基板を透過する際に生じる球面収差を打ち消す球面収差を有し、前記ホログラム光学素子は、該ホログラム光学素子の+1次回折光または-1次回折光に対し、前記対物レンズからの出射光が該出射光が導かれる光記録媒体の基板を透過する際に生じる球面収差と前記対物レンズが有する球面収差との和を打ち消す球面収差を有していることを特徴とする請求項1記載の光ヘッド装置。

【請求項3】 前記ホログラム光学素子は、基板上の干 30 歩縞バタンが前記対物レンズの有効径より小さい直径の 領域内にのみ形成されていることを特徴とする請求項1 記載の光ヘッド装置。

【請求項4】 前記ホログラム光学素子は、基板上の干渉縞パタンが前記対物レンズの有効径とほぼ同じ直径の領域内に形成され、前記干渉縞パタンが形成された面と反対の基板面に位相補償膜および波長フィルタ膜が前記対物レンズの有効径より小さい直径の領域外にのみ形成されていることを特徴とする請求項1記載の光ヘッド装置。

【請求項5】 前記ホログラム光学素子は、同心円状の干渉縞パタンを有し該干渉縞パタンの断面形状が階段状になされていることを特徴とする請求項1記載の光ヘッド装置。

【請求項 6】 前記光合波手段は、第一の半導体レーザの出射光の光記録媒体からの反射光および第二の半導体レーザの出射光の光記録媒体からの反射光を分波する機能を有しており、前記光検出部が第一の半導体レーザの出射光の光記録媒体からの反射光と第二の半導体レーザの出射光の光記録媒体からの反射光とを別個の受光素子 50

にて検出するものであることを特徴とする請求項1記載 の光ヘッド装置。

【請求項7】 前記光合波手段が、何れか一方の半導体レーザの出射光およびその光記録媒体からの反射光を透過させ、何れか他方の半導体レーザの出射光およびその光記録媒体からの反射光を反射するものであることを特徴とする請求項6記載の光ヘッド装置。

【請求項8】 前記光合波手段が偏光ビームスプリッタによって構成され、何れか一方の半導体レーザの出射光がS偏光として、何れか他方の半導体レーザの出射光がP偏光として該光合波手段に入射されることを特徴とする請求項6記載の光ヘッド装置。

【請求項9】 前記光検出部が第一の半導体レーザの出射光の光記録媒体からの反射光と第二の半導体レーザの出射光の光記録媒体からの反射光とを同一の受光素子にて検出するものであることを特徴とする請求項1記載の光ヘッド装置。

【請求項10】 前記光合波手段が、何れか一方の半導体レーザからの出射光をP偏光として透過させ、該何れ20 か一方の半導体レーザからの出射光の光記録媒体からの反射光をS偏光として反射し、何れか他方の半導体レーザの出射光を反射するものであることを特徴とする請求項9記載の光ヘッド装置。

【発明の詳細な説明】

[0 0 0 1]

【発明の属する技術分野】本発明は、光記録媒体に対し 記録や再生を行うための光ヘッド装置、特に二種類の異 なる基板厚さの光記録媒体に対し記録あるいは再生を行 うための光ヘツド装置に関するものである。

[0002]

【従来の技術】近年、ディジタルビデオディスク等の大容量光ディスクの規格化が進められている。ディジタルビデオディスクの規格の一つに、基板厚さ0.6 mmのディスクを用いるものがある。これに対し、従来のコンパクトディスク等の規格では、基板厚さ1.2 mmのディスクを用いる。そこで、ディジタルビデオディスクとコンパクトディスクの両方を再生できる光へッド装置においては、対物レンズがある基板厚さのディスクに対しては球面収差を打ち消すように設計されているため、別の基板厚さのディスクに対しては球面収差が残留し、正しく再生することができない。

【0003】ディジタルビデオディスクとコンパクトディスクの両方を再生できる従来の光ヘッド装置として、オプティカルレビュー第1巻第1号の27頁~29頁に記載された例がある。図22に従来の光ヘッド装置の構成を示す。光学系中にホログラム光学素子145を設け、透過光(0次光)を基板厚さ0.6 mmのディスクの再生に用い、+1次回折光を基板厚さ1.2 mmのディスクの再生に用いる。半導体レーザ143からの出射

光はハーフミラー144で約半分が反射され、コリメー タレンズ4で平行光化されてホログラム光学素子145 に入射する。ホログラム光学素子145の透過光は平行 光として対物レンズ6に入射し、基板厚さ0.6mmの ディスク7上に集光される。ディスク7からの反射光は 対物レンズ6を逆向きに透過し、再びホログラム光学素 子145で透過光と+1次回折光に分けられる。一方、 ホログラム光学素子145の+1次回折光は発散光とし て対物レンズ6に入射し、基板厚さ1.2mmのディス ク8上に集光される。ディスク8からの反射光は対物レ 10 ンズ6を逆向きに透過し、再びホログラム光学素子14 5で透過光と+1次回折光に分けられる。ディスク7か らの反射光のうちホログラム光学素子145の透過光、 およびディスク8からの反射光のうちホログラム光学素 子145の+1次回折光は、共にコリメータレンズ4に 平行光として入射する。 コリメータレンズ 4 の透過光は ハーフミラー144を約半分が透過し、凹レンズ146 を透過して光検出器147で受光される。光検出器14 7は4分割受光部を有し、フォーカス誤差信号はハーフ ミラー144で生じる非点収差を用いた非点収差法、ト 20 ラック/誤差信号はブッシュブル法によりそれぞれ検出 される。また、再生信号は4分割受光部の出力の和から 検出される。

【0004】対物レンズ6は、対物レンズ6からの出射 光が厚さ0.6mmの基板を透過する際に生じる球面収 差を打ち消す球面収差を有し、ホログラム光学素子14 5は、ホログラム光学素子145の+1次回折光に対 し、対物レンズ6からの出射光が厚さ1.2mmの基板

$$\eta_0 = s i n^2 \phi / \phi^2$$
 $\eta_{+1} = s i n^2 \phi / (\phi - \pi)^2$ 

但し、

$$\phi = 2\pi (n-1) h/\lambda$$

 $\phi = \pi/2$ のとき $\eta$ 。と $\eta_{+1}$ は等しく、 $\eta$ 。= $\eta_{+1}$ = 0. 405となる。この場合の往復の利用効率は、no<sup>2</sup>  $= \eta_{+1}^{2} = 0$ . 164となる。従って、半導体レーザ1 43の出力が通常の光ヘッド装置と同じであるとする と、光検出器147の受光量は通常の光ヘッド装置の 0. 164倍しか得られず、再生信号のS/Nが低下す る。光検出器147の受光量が通常の光ヘッド装置と同 光ヘッド装置の6.10倍に高める必要がある。ディス ク7、8の再生だけでなく記録を行うためには、半導体 レーザ143の出力をさらに高める必要があり、事実上 不可能である。

【0006】図22に示す従来の光ヘッド装置には、半 導体レーザの波長に関する課題もある。ディジタルビデ オディスクの規格では、波長635nm~655nmの 半導体レーザを用いるのに対し、従来のコンパクトディ スクの規格では、波長785 nmの半導体レーザを用い

を透過する際に生じる球面収差と対物レンズ 6 が有する 球面収差の和を打ち消す球面収差を有する。従って、ホ ログラム光学素子145の透過光は対物レンズ6により ディスク7上に無収差で集光され、ホログラム光学素子 145の+1次回折光は対物レンズ6によりディスク8 上に無収差で集光される。図23はホログラム光学素子 145の平面図である。ホログラム光学素子145は同 心円状の干渉縞のパタンを有し、+1次回折光に対して は、上に述べた球面収差補正と共に凹レンズとしての働 きをする。従って、対物レンズ6に対し、+1次回折光 のディスク8上の集光位置を透過光のディスク7上の集 光位置より遠ざけることができ、対物レンズ6からディ スク7、8の表面までの距離をほぼ等しくすることがで きる。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】図22に示す従来の光 ヘッド装置には、ホログラム光学素子145で入射光が 透過光と+1次回折光に分けられるため、各々の光に対 する利用効率が低下するという問題があった。図24は ホログラム光学素子145の断面図である。図24

(a) は断面が矩形状の場合であり、+1次回折光と同 じ効率で不要な-1次回折光が生じる。図24(b)は 断面が鋸歯状の場合であり、+1次回折光の効率が増加 して不要な-1次回折光の効率は減少する。このとき、 鋸歯領域の高さを2h、屈折率をn、入射光の波長をλ とすると、透過率 7。、+1次回折効率 7.1は以下の式 で与えられる。

(1)

(2)

(3)

べて高密度なディジタルビデオディスクを再生するた め、波長785nmに比べて集光スポット径を小さくで きる波長635nm~655nmの半導体レーザを用い る必要がある。一方、コンパクトディスクの一種とし て、CD-Rと呼ばれる追記型コンパクトディスクがあ る。これは記録媒体として有機色素を用いたものであ り、波長785nmでは70%以上の高い反射率が得ら じであるためには、半導体レーザ143の出力を通常の 40 れるが、波長635nm~655nmでは10%程度の 非常に低い反射率しか得られない。このため、従来の光 ヘッド装置では、追記型コンパクトディスクの再生は不 可能である。

> 【0007】したがって、本発明の解決すべき課題は、 二種類の異なる基板厚さのディスクに対し、

- ① 半導体レーザの出力を増大させることなく、再生信 号のS/Nを一種類の基板厚さのディスクを扱う場合と 同程度に維持することができ、
- ② 追記型コンパクトディスクをも含めて再生を行うこ る。従来の光ヘッド装置には、コンパクトディスクに比「50」とができると共に、記録をも行うことのできる光ヘッド

装置を提供できるようにすることである。

[0008]

【課題を解決するための手段】上記の課題は、光ヘッド

- ① 異なる波長で発振する二つの半導体レーザと、
- ② 一方の波長の光を透過させると共に、他方の波長の 光を反射する光合波手段と、
- ③ 一方の波長の光をほぼ100%透過させると共に、 他方の波長の光の-1次または+1次回折光を高効率で 取り出すことのできるホログラム光学素子と、を備える 10 ことによって解決することができる。

[0009]

【発明の実施の形態】本発明の光ヘッド装置は、第一の 波長で発振する第一の半導体レーザと、第二の波長で発 振する第二の半導体レーザと、前記第一の半導体レーザ からの出射光と前記第二の半導体レーザからの出射光を 合波することのできる光合波手段と、それぞれの半導体 レーザの出射光を第一または第二の光記録媒体に導くホ ログラム光学素子および対物レンズと、前記光合波手段 の前記ホログラム光学素子と対向する側に設けられた前 20 記第一および第二の半導体レーザの出射光の光記録媒体 からの反射光を受光する光検出部と、を備え、前記ホロ グラム光学素子による前記第一の半導体レーザの透過光 および前記第二の半導体レーザの-1次回折光を用いる ことにより、あるいは、前記ホログラム光学素子による 前記第一の半導体レーザの+1次回折光および前記第二 の半導体レーザの透過光を用いることにより、前記第一 の半導体レーザの出射光を第一の光記録媒体に導き、前 記第二の半導体レーザの出射光を前記第一半導体レーザ より厚い第二の光記録媒体に導き、それぞれの光記録媒 30 体に対して再生または再生および記録を行うことができ るようにしたものである。

【0010】そして、より好ましくは、前記対物レンズ は、前記ホログラム光学素子からの透過光が該透過光が 導かれる光記録媒体の基板を透過する際に生じる球面収 差を打ち消す球面収差を有し、前記ホログラム光学素子 は、該ホログラム光学素子の+1次回折光または-1次 回折光に対し、前記対物レンズからの出射光が該出射光 が導かれる光記録媒体の基板を透過する際に生じる球面 収差と前記対物レンズが有する球面収差との和を打ち消 40 す球面収差を有するものである。

【0011】本発明の光ヘッド装置は、上述したよう に、二つの異なる波長の半導体レーザとホログラム光学 素子を有し、一方の半導体レーザから出射したホログラ ム光学素子の透過光を用いて一方のディスクを再生し、 他方の半導体レーザから出射したホログラム光学素子の +1次回折光または-1次回折光を用いて一方のディス クとは基板厚さの異なる他方のディスクを再生する。ホ ログラム光学素子の透過率および±1次回折効率は入射

対しては100%に近い透過率が得られ、他方の半導体 レーザの波長に対しては高い+1次回折効率または-1 次回折効率が得られるような設計を行うことにより、再 生信号のS/Nは通常と同程度となり、半導体レーザの 出力も通常と同程度で済み、再生だけでなく記録を行う ことも可能になる。また、一方の半導体レーザの波長を 785 nmにすることにより、追記型コンパクトディス クの再生も可能となる。

[0012]

【実施例】次に、図面を参照して本発明の実施例につい て説明する。

[第一の実施例] 図1に、本発明の光ヘッド装置の第一 の実施例の構成を示す。モジュール1およびモジュール 2には、半導体レーザと、ディスクからの反射光を受光 する検出光学系が内蔵されている。モジュール1内の半 導体レーザの波長は635nm、モジュール2内の半導 体レーザの波長は785nmである。波長フィルタ3 は、波長635nmの光をほぼ完全に透過させ、波長7 85 nmの光をほぼ完全に反射させる働きをする。モジ ュール1内の半導体レーザからの出射光は波長フィルタ 3を透過し、コリメータレンズ4で平行光化されてホロ グラム光学素子5に入射する。ホログラム光学素子5の 透過光は平行光として対物レンズ6に入射し、基板厚さ 0.6 mmのディスク7上に集光される。ディスク7か らの反射光は対物レンズ6を逆向きに透過し、再びホロ グラム光学素子5に入射する。ホログラム光学素子5の 透過光はコリメータレンズ4に平行光として入射する。 コリメータレンズ4の透過光は波長フィルタ3を透過 し、モジュール1内の検出光学系で受光される。

【0013】一方、モジュール2内の半導体レーザから の出射光は波長フィルタ3で反射され、コリメータレン ズ4で平行光化されてホログラム光学素子5に入射す る。ホログラム光学素子5の-1次回折光は発散光とし て対物レンズ6に入射し、基板厚さ1.2mmのディス ク8上に集光される。ディスク8からの反射光は対物レ ンズ6を逆向きに透過し、再びホログラム光学素子5に 入射する。ホログラム光学素子5の-1次回折光はコリ メータレンズ4に平行光として入射する。コリメータレ ンズ4の透過光は波長フィルタ3で反射され、モジュー ル2内の検出光学系で受光される。ホログラム光学素子 5と対物レンズ6は、アクチュエータで一体駆動され

【0014】対物レンズ6は、波長635nmの対物レ ンズ6からの出射光が厚さ0.6mmの基板を透過する 際に生じる球面収差を打ち消す球面収差を有し、ホログ ラム光学素子5は、ホログラム光学素子5の-1次回折 光に対し、波長785nmの対物レンズ6からの出射光 が厚さ1.2mmの基板を透過する際に生じる球面収差 と対物レンズ6が有する球面収差の和を打ち消す球面収 光の波長に依存するため、一方の半導体レーザの波長に 50 差を有する。従って、波長635nmのホログラム光学

素子5の透過光は対物レンズ6によりディスク7上に無 収差で集光され、波長785nmのホログラム光学素子 5の-1次回折光は対物レンズ6によりディスク8上に 無収差で集光される。ホログラム光学素子5は、図23 に示すホログラム光学素子145と同様に同心円状の干 渉縞のパタンを有し、-1次回折光に対しては、上に述 べた球面収差補正と共に凹レンズとしての働きをする。 従って、対物レンズ6に対し、-1次回折光のディスク 8上の集光位置を透過光のディスク7上の集光位置より 遠ざけることができ、対物レンズ6からディスク7、8 10 6、17部のエッチングを行う。 の表面までの距離をほぼ等しくすることができる。

【0015】図2はホログラム光学素子5の断面の拡大 図である。断面を矩形状でなく図のように 4 レベルの階 段状にすることにより、-1次回折光の効率が増加して

不要な+1次回折光の効率は減少する。図2 (a) はガ ラス基板9上にSiO: 10を堆積させて作製した場合 であり、図2(b)はガラス基板14をエッチングして 作製した場合である。 どちらも作製には2枚のフォトマ スクを用いる。図2 (a) では、1枚目のフォトマスク を用いて領域11部の堆積を行い、2枚目のフォトマス クを用いて領域12、13部の堆積を行う。図2(b) では、1枚目のフォトマスクを用いて領域15部のエッ チングを行い、2枚目のフォトマスクを用いて領域1

【0016】このとき、各段の高さまたは深さをh/ 2、屈折率をn、入射光の波長をλとすると、透過率 n 。、+1次回折効率 $\eta_+$ 、-1次回折効率 $\eta_-$ は以下の 式で与えられる。

$$\eta_{\bullet} = \cos^{2} (\phi/2) \cos^{2} (\phi/4) \tag{4}$$

$$\eta_{11} = (8/\pi^2) \text{ sin}^2 (\phi/2) \text{ cos}^2 [(\phi-\pi)/4]$$
 (5)

$$\eta_{-1} = (8/\pi^2) \text{ sin}^2 (\phi/2) \text{ cos}^2 [(\phi+\pi)/4]$$
 (6)

但し、

$$\phi = 2\pi (n-1) h/\lambda$$

(7)

35 nmに対しては $\phi = 4\pi$ であるから $\eta_0 = 1$ 、 $\eta_{++}$ = 0、 $\eta_{-1}$  = 0となり、 $\lambda$  = 785 nmに対しては $\phi$  = 3.  $23\pi$  であるから $\eta_0 = 0.085$ 、 $\eta_{11} = 0.0$ 23、η-1=0.686となる。この場合の往復の利用 効率は、 $\lambda = 635$  nmに対しては $\eta_0$  = 1 となり、 $\lambda$ = 78.5 nmに対しては $\eta_{-1}^2 = 0.471$ となる。

【0017】従って、波長635nmに関しては、ディ スク7の再生信号のS/Nは通常と同程度であり、モジ ュール1内の半導体レーザの出力も通常と同程度で済 み、ディスク7の再生だけでなく記録を行うことも可能 30 である。一方、波長785nmに関しては、モジュール 2内の半導体レーザの出力が通常の光ヘッド装置と同じ であるとすると、モジュール2内の検出光学系の受光量 は通常の光ヘッド装置の0.471倍になるが、この程 度であればディスク8の再生信号のS/Nは殆んど低下 しない。また、モジュール2内の検出光学系の受光量が 通常の光ヘッド装置と同じであるためには、モジュール 2内の半導体レーザの出力を通常の光ヘッド装置の2. 12倍に高める必要があるが、この程度であれば容易に 実現可能である。また、モジュール2内の半導体レーザ 40 の波長は785nmであるため、ディスク8が追記型コ ンパクトディスクの場合にも再生が可能である。

【0018】図3はホログラム光学素子5の断面の全体 図である。対物レンズ6の有効径を2aとしたとき、干 渉縞のパタンはこれより小さい直径2 bの領域内にのみ 形成されている。直径26の領域外では、波長635n m、785nmの光はホログラム光学素子5を完全に透 過する。従って、波長635nmの光は、直径2aの領 域内の全体にわたってホログラム光学素子5を100%

例えばh=2. 76  $\mu$ m、n=1. 46のとき、 $\lambda=6$  20 ホログラム光学素子5で-1次回折光として68.8% が回折され、直径2 bの領域外では全く回折されない。 対物レンズ6の焦点距離を f とすると、波長635n m、785nmの光に対する実効的な開口数は、それぞ na/f、b/fで与えられる。例えばf=2. 6mm、a=1.56mm、b=1.17mmとすると、a /f=0.6、b/f=0.45となる。

【0019】 [第二の実施例] 図4に、本発明の光ヘッ ド装置の第二の実施例の構成を示す。モジュール1およ びモジュール2には、半導体レーザと、ディスクからの 反射光を受光する検出光学系が内蔵されている。モジュ ール1内の半導体レーザの波長は635nm、モジュー ル2内の半導体レーザの波長は785nmである。波長 フィルタ3は、波長635nmの光をほぼ完全に透過さ せ、波長785nmの光をほぼ完全に反射させる働きを する。モジュール1内の半導体レーザからの出射光は波 長フィルタ3を透過し、コリメータレンズ4で平行光化 されてホログラム光学素子18に入射する。ホログラム 光学素子18の+1次回折光は収束光として対物レンズ 19に入射し、基板厚さ0.6mmのディスク7上に集 光される。ディスク7からの反射光は対物レンズ19を 逆向きに透過し、再びホログラム光学素子18に入射す る。ホログラム光学素子18の+1次回折光はコリメー タレンズ4に平行光として入射する。コリメータレンズ 4の透過光は波長フィルタ3を透過し、モジュール1内 の検出光学系で受光される。一方、モジュール2内の半 導体レーザからの出射光は波長フィルタ3で反射され、 コリメータレンズ4で平行光化されてホログラム光学素 子18に入射する。ホログラム光学素子18の透過光は 平行光として対物レンズ19に入射し、基板厚さ1.2 透過し、波長785nmの光は、直軽2bの領域内では 50 mmのディスク8上に集光される。ディスク8からの反

射光は対物レンズ19を逆向きに透過し、再びホログラム光学素子18に入射する。ホログラム光学素子18の透過光はコリメータレンズ4に平行光として入射する。コリメータレンズ4の透過光は波長フィルタ3で反射され、モジュール2内の検出光学系で受光される。ホログラム光学素子18と対物レンズ19は、アクチュエータで一体駆動される。

【0020】対物レンズ19は、波長785nmの対物 レンズ19からの出射光が厚さ1.2mmの基板を透過 する際に生じる球面収差を打ち消す球面収差を有し、ホ 10 ログラム光学素子18は、ホログラム光学素子18の+ 1次回折光に対し、波長635nmの対物レンズ19か らの出射光が厚さ0.6mmの基板を透過する際に生じ る球面収差と対物レンズ19が有する球面収差の和を打 ち消す球面収差を有する。従って、波長635nmのホ ログラム光学素子18の+1次回折光は対物レンズ19 によりディスク7上に無収差で集光され、波長785 n mのホログラム光学素子18の透過光は対物レンズ19 によりディスク8上に無収差で集光される。ホログラム 光学素子18は、図23に示すホログラム光学素子14 20 5と同様に同心円状の干渉縞のパタンを有し、+1次回 折光に対しては、上に述べた球面収差補正と共に凸レン ズとしての働きをする。従って、対物レンズ19に対 し、 + 1 次回折光のディスク 7 上の集光位置を透過光の ディスク8上の集光位置より近づけることができ、対物 レンズ19からディスク7、8の表面までの距離をほぼ 等しくすることができる。

【0021】図5はホログラム光学素子18の断面の拡

大図である。 断面を矩形状でなく図のように 4 レベルの 階段状にすることにより、+1次回折光の効率が増加し て不要な-1次回折光の効率は減少する。図5(a)は ガラス基板20上にSiO,21を堆積させて作製した 場合であり、図5(b)はガラス基板25をエッチング して作製した場合である。 どちらも作製には2枚のフォ トマスクを用いる。図5 (a)では、1枚目のフォトマ スクを用いて領域22部の堆積を行い、2枚目のフォト マスクを用いて領域23、24部の堆積を行う。図5 (b) では、1枚目のフォトマスクを用いて領域26部 のエッチングを行い、2枚目のフォトマスクを用いて領 域 2 7、 2 8 部のエッチングを行う。このとき、各段の 40 高さまたは深さをh/2、屈折率をn、入射光の波長を 入とすると、透過率 $\eta$ 。、+1次回折効率 $\eta$ ..、-1次 回折効率 $\eta_{-1}$ は(4)~(7)式で与えられる。例えば h=3.  $45 \mu m$ , n=1.  $46 \sigma$ とき、 $\lambda = 635 n$ mに対しては $\phi = 5\pi$ であるから $\eta_0 = 0$ 、 $\eta_{++} = 0$ . 811、 $\eta_1 = 0$ となり、 $\lambda = 785$  nmに対しては  $\phi$ = 4.  $0.4\pi$  であるから  $\eta_0 = 0$ . 9.95、 $\eta_{+1} = 0$ . 002、 $\eta_{-1}=0$ . 001となる。この場合の往復の利 用効率は、 $\lambda = 635$  nmに対しては $\eta_{11}^{1} = 0$ . 65 8となり、 $\lambda = 785$  nmに対しては $\eta_0^2 = 0$ . 990

となる。

【0022】従って、波長635nmに関しては、モジ ュール1内の半導体レーザの出力が通常の光ヘツド装置 と同じであるとすると、モジュール1内の検出光学系の 受光量は通常の光ヘッド装置の0.658倍になるが、 この程度であればディスク7の再生信号のS/Nは殆ん ど低下しない。また、モジュール1内の検出光学系の受 光量が通常の光ヘツド装置と同じであるためには、モジ ュール1内の半導体レーザの出力を通常の光ヘッド装置 の1. 52倍に高める必要があるが、この程度であれば 容易に実現可能である。一方、波長785nmに関して は、ディスク8の再生信号のS/Nは通常と同程度であ り、モジュール2内の半導体レーザの出力も通常と同程 度で済み、ディスク8の再生だけでなく記録を行うこと も可能である。また、モジュール2内の半導体レーザの 波長は785nmであるため、ディスク8が追記型コン パクトディスクの場合にも再生が可能である。

【0023】図6はホログラム光学素子18の断面の全 体図である。対物レンズ19の有効径を2aとしたと き、干渉縞のパタンは直径2 a の領域内の全体にわたっ て形成されている。また、波長フィルタ膜29および位 相補償膜30が、これより小さい直径2bの領域外にの み形成されている。波長フィルタ膜29は、波長635 nmの光をほぼ完全に透過させ、波長785nmの光を ほぼ完全に反射させる働きをする。位相補償膜30は、 波長635 nmに対し、波長フィルタ膜29 および位相 補償膜30を通る光と空気中を通る光の位相差を2πに 調整する働きをする。すなわち、直径2bの領域外で は、波長635nmの光はホログラム光学素子18を完 全に透過し、波長785 nmの光はホログラム光学素子 18で完全に反射される。従って、波長635 nmの光 は、直径2 aの領域内の全体にわたってホログラム光学 素子18で+1次回折光として81.1%が回折され、 波長785nmの光は、直径2bの領域内ではホログラ ム光学素子18を99.5%が透過し、直径2bの領域 外では全く透過しない。対物レンズ19の焦点距離をf とすると、波長635nm、785nmの光に対する実 効的な開口数は、それぞれa/f、b/fで与えられ る。例えばf=2.6mm、a=1.56mm、b= 0.45となる。

【0024】ホログラム光学素子5は、プラスチックまたはガラスによる一体成形で作製することも可能である。ホログラム光学素子18も、波長フィルタ膜29以外の部分は、プラスチックまたはガラスによる一体成形で作製することも可能である。さらに、ホログラム光学素子5、18を、それぞれ対物レンズ6、19上に直接形成することも可能である。

【0025】図7に、本発明の光ヘッド装置の実施例に、 50 用いる波長フィルタの構成を示す。図7(a)に示す波

12

長フィルタ3は、二つのガラスのブロックを誘電体多層 膜34を介して貼り合わせたものである。波長635 n mの入射光31は、誘電体多層膜34に入射角45度で 入射し、ほぼ完全に透過して直進する。一方、波長78 5 n mの入射光32は、誘電体多層膜34に入射角45 度で入射し、ほぼ完全に反射されて進行方向が90度曲 げられる。図7(b)に示す波長フィルタ33は、三つ のガラスのブロックを誘電体多層膜35、36を介して 貼り合わせたものである。波長635 n mの入射光31 は、誘電体多層膜35に入射角22.5度で入射し、ほ ぼ完全に透過して直進する。一方、波長785 n mの入 射光32は、誘電体多層膜35、36に入射角22.5 度で入射し、二回ほぼ完全に反射されて進行方向が90 度曲げられる。一般に、波長フィルタは誘電体多層膜へ の入射角が小さいほど設計が容易である。

【0026】図7に示す波長フィルタ3、33は、波長 635nmの光をほぼ完全に透過させ、波長785nm の光をほぼ完全に反射させるように設計が行われている が、波長785nmの光をほぼ完全に透過させ、波長6 35 nmの光をほぼ完全に反射させるように設計を行う ことも可能である。これを用いる場合は、図1および図 4のモジュール1内の半導体レーザの波長を785n m、モジュール2内の半導体レーザの波長を635nm とすればよい。また、半導体レーザからの出射光の偏光 方向とディスクからの反射光の偏光方向が同じ場合は、 波長フィルタの代わりに偏光ピームスプリッタを用いる ことも可能である。例えば、波長635nmの光は偏光 ビームスブリッタにP偏光として入射させ、波長785 nmの光は偏光ビームスプリッタにS偏光として入射さ せれば、前者はほぼ完全に透過し、後者はほぼ完全に反 30 射される。

【0027】図8に、本発明の光へッド装置の実施例を再生専用型のディスクに適用した場合のモジュールの構成を示す。このモジュールは、半導体レーザ37、光検出器38を収納したパッケージ39と、パッケージ39の窓部にスペーサ42を挟んで設けられた回折格子40、ホログラム光学素子41から構成される。回折格子40およびホログラム光学素子41は、ガラス基板上にSiO,でパタンが形成された構造であり、入射光の一部を透過、一部を回折させる働きをする。半導体レーザ37からの出射光は、回折格子40で透過光と±1次回折光の三つの光に分けられ、それぞれホログラム光学素子41を約50%が透過してディスクに向かう。ディスクで反射された三つの光は、それぞれホログラム光学素子41で±1次回折光として約40%が回折され、回折格子40を透過して光検出器38で受光される。

【0028】図9に、図8のモジュールにおける半導体 れる。偏光性ホログラム光学素子65は、図13に示す レーザ37の光検出器38への実装形態を示す。図9 ように、複屈折性を有するニオブ酸リチウム基板67上 (a) はガラスのミラーを用いた場合である。半導体レ にプロトン交換領域68と位相補償膜69でパタンが形 ーザ37は、光検出器38上にヒートシンク43を介し 50 成された構造であり、入射光のうち常光は全て透過さ

て設置されている。半導体レーザ37から側方に出射された光は、ガラスのミラー44で反射されて上方に向かう。一方、図9(b)は光検出器にエッチングで形成されたミラーを用いた場合である。半導体レーザ37は、光検出器38にエッチングで形成された凹部に設置されている。半導体レーザ37から側方に出射された光は、光検出器38にエッチングで形成されたミラーで反射されて上方に向かう。

【0029】図10(a)に回折格子40、図10(b)にホログラム光学素子41の干渉縞のパタンをそれぞれ示す。回折格子40は中心付近の領域45にのみパタンを有する。半導体レーザ37からの出射光は領域45の外部を通る。また、ホログラム光学素子41はオフアクシスの同心円状のパタンを有し、+1次回折光に対しては凸レンズ、-1次回折光に対しては凹レンズとしての働きをする。

【0030】図11に、光検出器38の受光部のパタン と、受光部上の光スポットの配置を示す。往路の回折格 子40の透過光のうち、復路のホログラム光学素子41 の+1次回折光は、3分割された受光部46~48上に 光スポット56を形成し、復路のホログラム光学素子4 1の-1次回折光は、3分割された受光部49~51上 に光スポット57を形成する。また、往路の回折格子4 0の+1次回折光のうち、復路のホログラム光学素子4 1の±1次回折光は、それぞれ受光部52、53上に光 スポット58、59を形成し、往路の回折格子40のー 1次回折光のうち、復路のホログラム光学素子41の土 1次回折光は、それぞれ受光部54、55上に光スポッ ト60、61を形成する。受光部46~48、52、5 4は集光点の後方に位置しており、受光部49~51、 53、55は集光点の前方に位置している。受光部46 ~55からの出力をそれぞれV46~V55で表わす と、フォーカス誤差信号は公知のスポットサイズ法によ 0. (V46+V48+V50) - (V47+V49+V51)の演算から得られ、トラック誤差信号は公知の 3ピーム法により、(V52+V53) - (V54+V 55) の演算から得られる。また、ディスクの再生信号 は、V46+V47+V48+V49+V50+V51 の演算から得られる。

【0031】図12に、本発明の光ヘッド装置の実施例を追記型のディスクまたは書換型の相変化ディスクに適用した場合のモジュールの構成を示す。このモジュールは、半導体レーザ62、光検出器63を収納したパッケージ64と、パッケージ64の窓部に設けられた偏光性ホログラム光学素子65、1/4波長板66から構成される。偏光性ホログラム光学素子65は、図13に示すように、複屈折性を有するニオブ酸リチウム基板67上にプロトン交換領域68と位相補償膜69でパタンが形成された構造であり、入射光のうち常光は全て透過さ

せ、異常光は全て回折させる働きをする。半導体レーザ 62からの出射光は、偏光性ホログラム光学素子65に 常光として入射して全て透過し、1/4波長板66で直 線偏光から円偏光に変換されてディスクに向かう。ディ スクからの反射光は、1/4波長板66で円偏光から直 線偏光に変換され、偏光性ホログラム光学素子65に異 常光として入射し、±1次回折光として約80%が回折 されて光検出器63で受光される。半導体レーザ62の 光検出器63への実装形態は図9と同様である。

【0032】図14に偏光性ホログラム光学素子65の 10 干渉縞のパタンを示す。偏光性ホログラム光学素子65 は四つの領域70~73に分割されている。また、偏光 性ホログラム光学素子65の光学軸74は、半導体レー ザ62からの出射光の偏光方向と垂直な方向に設定され ている。図15に、光検出器63の受光部のバタンと、 受光部上の光スポットの配置を示す。偏光性ホログラム 光学素子65の領域70からの+1次回折光は、2分割 された受光部75、76の分割線上に光スポット83を 形成し、領域70からの-1次回折光は受光部82上に 光スポット87を形成する。偏光性ホログラム光学素子 20 65の領域71からの+1次回折光は、2分割された受 光部77、78の分割線上に光スポット84を形成し、 領域71からの-1次回折光は受光部81上に光スポッ ト88を形成する。また、偏光性ホログラム光学素子6 5の領域72からの±1次回折光は、それぞれ受光部7 9、82上に光スポット85、89を形成し、領域73 からの±1次回折光は、それぞれ受光部80、81上に 光スポット86、90を形成する。受光部75~82か らの出力をそれぞれV75~V82で表わすと、フォー カス誤差信号は公知のフーコー法により、 (V75+V 30 78) - (V76+V77) の演算から得られ、トラッ ク誤差信号は公知のブッシュブル法により、V79-V 、 80の演算から得られる。また、ディスクの再生信号 は、V81+V82の演算から得られる。

【0033】図16に、本発明の光ヘッド装置の実施例 を書換型の光磁気ディスクに適用した場合のモジュール の構成を示す。このモジュールは、半導体レーザ91、 光検出器92、マイクロプリズム93、94を収納した パッケージ95と、パッケージ95の窓部にスペーサ9 8を挟んで設けられた偏光性回折格子96、ホログラム 40 光学素子97から構成される。偏光性回折格子96は、 図13に示す偏光性ホログラム光学素子65と同様の構 造であり、入射光のうち常光は一部を透過、一部を回折 させ、異常光は全て回折させる働きをする。半導体レー ザ91からの出射光は、ホログラム光学素子97を約8 0%が透過し、偏光性回折格子96に常光として入射 し、約90%が透過してディスクに向かう。ディスクか らの反射光のうち、常光成分の約8%と異常光成分の約 80%は偏光性回折格子96で±1次回折光として回折

折光はマイクロプリズム94を介して光検出器92で受 光される。また、常光成分の約90%は偏光性回折格子 96を透過してホログラム光学素子97に入射し、±1 次回折光として約16%が回折されて光検出器92で受 光される。半導体レーザ91の光検出器92への実装形 態は図9と同様である。

【0034】図17 (a) に偏光性回折格子96、図1 7 (b) にホログラム光学素子97の干渉縞のパタンを それぞれ示す。偏光性回折格子96の光学軸99は、半 導体レーザ91からの出射光の偏光方向と垂直な方向に 設定されている。また、ホログラム光学素子97は中心 付近にのみパタンを有し、四つの領域100~103に 分割されている。ディスクからの反射光のうち、偏光性 回折格子96の透過光は領域100~103の内部を通 り、偏光性回折格子96の±1次回折光は領域100~ 103の外部を通る。ホログラム光学素子97の領域1 00、101はオフアクシスの同心円状のパタンを有 し、+1次回折光に対しては凸レンズ、-1次回折光に 対しては凹レンズとしての働きをする。

【0035】図18にマイクロブリズム93の構成を示 す。マイクロブリズム93は、三つのガラスのブロック を誘電体多層膜107、108を介して貼り合わせたも のである。入射光104のP偏光成分は誘電体多層膜1 07をほぼ完全に透過して透過光105となり、入射光 104のS偏光成分は誘電体多層膜107、108で二 回ほぼ完全に反射されて反射光106となる。マイクロ プリズム94の構成も同様である。図19に、光検出器 92の受光部のパタンと、受光部上の光スポットの配置 を示す。偏光性回折格子96からの+1次回折光は、マ イクロプリズム93を検光子として透過光と反射光に分 離され、透過光は受光部109上に光スポット123、 反射光は受光部110上に光スポット124をそれぞれ 形成する。また、偏光性回折格子96からのー1次回折 光は、マイクロブリズム94を検光子として透過光と反 射光に分離され、透過光は受光部111上に光スポット 125、反射光は受光部112上に光スポット126を それぞれ形成する。一方、ホログラム光学素子97の領 域100、101からの+1次回折光は、3分割された 受光部113~115上にそれぞれ光スポット127、 128を形成し、領域100、101からの-1次回折 光は、3分割された受光部116~118上にそれぞれ 光スポット129、130を形成する。受光部113~ 115は集光点の後方に位置しており、受光部116~ 118は集光点の前方に位置している。また、ホログラ ム光学素子97の領域102からの±1次回折光は、そ れぞれ受光部119、122上に光スポット131、1 33を形成し、領域103からの±1次回折光は、それ ぞれ受光部120、121上に光スポット132、13 4を形成する。受光部109~122からの出力をそれ され、+1次回折光はマイクロブリズム93、-1次回 50 ぞれV109~V122で表わすと、フォーカス誤差信

号は公知のスポットサイズ法により、(V113+V115+V117) - (V114+V116+V118) の演算から得られ、トラック誤差信号は公知のブッシュブル法により、(V119+V122) - (V120+V121) の演算から得られる。また、ディスクの再生信号は、(V109+V111) - (V110+V112) の演算から得られる。

【0036】図1および図4に示す本発明の光ヘッド装置の実施例は、いずれも小型化のために半導体レーザと検出光学系を内蔵した二個のモジュールを用いた構成で 10あるが、半導体レーザと検出光学系を別々に設けた二組のブロックを用いた構成も可能である。

【0037】[第三の実施例]図20に、本発明の光へッド装置の第三の実施例の構成を示す。モジュール136には、半導体レーザと、ディスクからの反射光を受光する検出光学系が内蔵されている。半導体レーザ135の波長は635nm、モジュール136内の半導体レーザの波長は785nmである。波長フィルタ137は、波長635nmのP偏光をほぼ完全に透過させ、波長635nmのS偏光および波長785nmの光をほぼ完全20に反射させる働きをする。1/4波長板138は波長635nmに対して最適設計されている。

【0038】半導体レーザ135からの出射光は、波長 フィルタ137にP偏光として入射して全て透過し、コ リメータレンズ4で平行光化され、1/4波長板138 で直線偏光から円偏光に変換されてホログラム光学素子 5に入射する。ホログラム光学素子5の透過光は平行光 として対物レンズ6に入射し、基板厚さ0.6mmのデ ィスク7上に集光される。ディスク7からの反射光は対 物レンズ6を逆向きに透過し、再びホログラム光学素子 5に入射する。ホログラム光学素子5の透過光は、1/ 4波長板138で円偏光から直線偏光に変換され、コリ メータレンズ4に平行光として入射する。コリメータレ ンズ4の透過光は、波長フィルタ137にS偏光として 入射して全て反射され、モジュール138内の検出光学 系で受光される。一方、モジュール138内の半導体レ ーザからの出射光は波長フィルタ137で反射され、コ リメータレンズ4で平行光化され、1/4波長板138 で直線偏光から楕円偏光に変換されてホログラム光学素 子5に入射する。ホログラム光学素子5の-1次回折光 40 は発散光として対物レンズ6に入射し、基板厚さ1.2 mmのディスク8上に集光される。ディスク8からの反 射光は対物レンズ6を逆向きに透過し、再びホログラム 光学素子5に入射する。ホログラム光学素子5の-1次 回折光は、1/4波長板138で楕円偏光から別の楕円 偏光に変換され、コリメータレンズ4に平行光として入 射する。コリメータレンズ4の透過光は波長フィルタ1 37で反射され、モジュール136内の検出光学系で受 光される。ホログラム光学素子5と対物レンズ6は、ア クチュエータで一体駆動される。モジュール136の構 50

成は、図12に示すモジュールの構成から1/4波長板66を除去したものである。

【0039】[第四の実施例]図21に、本発明の光へッド装置の第四の実施例の構成を示す。モジュール139には、半導体レーザと、ディスクからの反射光を受光する検出光学系が内蔵されている。モジュール139内の半導体レーザの波長は635nm、半導体レーザ140の波長は785nmである。波長フィルタ141は、波長635nmの光および波長785nmのP偏光をほぼ完全に透過させ、波長785nmのS偏光をほぼ完全に反射させる働きをする。1/4波長板142は波長785nmに対して最適設計されている。

【0040】モジュール139内の半導体レーザからの出射光は波長フィルタ141を透過し、コリメータレンズ4で平行光化され、1/4波長板142で直線偏光から楕円偏光に変換されてホログラム光学素子5に入射する。ホログラム光学素子5の透過光は平行光として対物レンズ6に入射し、基板厚さ0.6mmのディスク7上に集光される。ディスク7からの反射光は対物レンズ6を逆向きに透過し、再びホログラム光学素子5に入射する。ホログラム光学素子5の透過光は、1/4波長板142で楕円偏光から別の楕円偏光に変換され、コリメータレンズ4に平行光として入射する。コリメータレンズ4に平行光として入射する。コリメータレンズ4の透過光は波長フィルタ141を透過し、モジュール139内の検出光学系で受光される。

【0041】一方、半導体レーザ140からの出射光 は、波長フィルタ141にS偏光として入射して全て反 射され、コリメータレンズ4で平行光化され、1/4波 長板142で直線偏光から円偏光に変換されてホログラ ム光学素子5に入射する。ホログラム光学素子5の-1 次回折光は発散光として対物レンズ6に入射し、基板厚 さ1. 2 mmのディスク8上に集光される。ディスク8 からの反射光は対物レンズ6を逆向きに透過し、再びホ ログラム光学素子5に入射する。ホログラム光学素子5 の-1次回折光は、1/4波長板142で円偏光から直 線偏光に変換され、コリメータレンズ4に平行光として 入射する。コリメータレンズ4の透過光は、波長フィル タ141にP偏光として入射して全て透過し、モジュー ル139内の検出光学系で受光される。ホログラム光学 素子5と対物レンズ6は、アクチュエータで一体駆動さ れる。モジュール139の構成は、図12に示すモジュ ールの構成から1/4波長板66を除去したものであ る。

【0042】図20および図21に示す本発明の光ヘッド装置の実施例は、いずれも小型化のために半導体レーザと検出光学系を内蔵した一個のモジュールと一個の半導体レーザを用いた構成であるが、半導体レーザと検出光学系を別々に設けた一組のブロックと一個の半導体レーザを用いた構成も可能である。

[0043]

【発明の効果】以上に述べたように、本発明の光ヘッド 装置は、二つの異なる波長の半導体レーザとホログラム 光学素子を有し、一方の半導体レーザから出射したホロ グラム光学素子の透過光を用いて一方のディスクを記録 ・再生し、他方の半導体レーザから出射したホログラム 光学素子の+1次回折光または-1次回折光を用いて-方のディスクとは厚さの異なる他方のディスクを記録・ 再生するものであり、そしてホログラム光学素子の透過 率および±1次回折効率は入射光の波長に依存している ため、一方の半導体レーザの波長に対しては100%に 10 近い透過率が得られ、他方の半導体レーザの波長に対し ても高い+1次または-1次回折効率が得られるように 設計を行うことにより、再生信号のS/Nは通常と同程 度となり、半導体レーザの出力も通常と同程度で済み、 再生だけでなく記録を行うことも可能な光へツド装置を 実現することができる。また、本発明によれば、一方の 半導体レーザの波長を785nmにすることにより、追 記型コンパクトディスクの再生も可能な光ヘッド装置を 実現することができる。

#### 【図面の簡単な説明】

- 【図1】本発明の光ヘッド装置の第一の実施例の構成を 示す図である。
- 【図2】本発明の光ヘッド装置の第一の実施例に用いる ホログラム光学素子の断面の拡大図である。
- 【図3】本発明の光ヘッド装置の第一の実施例に用いる ホログラム光学素子の断面の全体図である。
- 【図4】本発明の光ヘッド装置の第二の実施例の構成を 示す図である。
- 【図5】本発明の光ヘッド装置の第二の実施例に用いる ホログラム光学素子の断面の拡大図である。
- 【図6】本発明の光ヘッド装置の第二の実施例に用いる ホログラム光学素子の断面の全体図である。
- 【図7】 本発明の光ヘッド装置の第一および第二の実施 例に用いる波長フィルタの構成を示す図である。
- 【図8】本発明の光ヘッド装置の実施例を再生専用型の ディスクに適用した場合のモジュールの構成を示す図で ある。
- 【図9】本発明の光ヘッド装置の実施例に用いる図8の モジュールにおける、半導体レーザの光検出器への実装 形態を示す図である。
- 【図10】本発明の光ヘッド装置の実施例に用いる図8 のモジュールにおける、回折格子およびホログラム光学 素子の干渉縞のパタンを示す図である。
- 【図11】本発明の光ヘッド装置の実施例に用いる図8 のモジュールにおける、光検出器の受光部のパタンと受 光部上の光スポットの配置を示す図である。
- 【図12】本発明の光ヘッド装置の実施例を追記型のデ ィスクまたは書換型の相変化ディスクに適用した場合の モジュールの構成を示す図である。
- 【図13】本発明の光ヘッド装置の実施例に用いる図1 50 30 位相補償膜

2のモジュールにおける、偏光性ホログラム光学素子の 構造を示す図である。

【図14】本発明の光ヘッド装置の実施例に用いる図1 2のモジュールにおける、偏光性ホログラム光学素子の 干渉縞のパタンを示す図である。

【図15】本発明の光ヘッド装置の実施例に用いる図1 2のモジュールにおける、光検出器の受光部のパタンと 受光部上の光スポットの配置を示す図である。

【図16】本発明の光ヘッド装置の実施例を書換型の光 磁気ディスクに適用した場合のモジュールの構成を示す 図である。

【図17】本発明の光ヘッド装置の実施例に用いる図1 8のモジュールにおける、偏光性回折格子およびホログ ラム光学素子の干渉縞のパタンを示す図である。

【図18】本発明の光ヘッド装置の実施例に用いる図1 6のモジュールにおける、マイクロブリズムの構成を示 す図である。

【図19】本発明の光ヘッド装置の実施例に用いる図1 6のモジュールにおける、光検出器の受光部のパタンと 20 受光部上の光スポットの配置を示す図である。

【図20】本発明の光ヘッド装置の第三の実施例の構成 を示す図である。

【図21】本発明の光ヘッド装置の第四の実施例の構成 を示す図である。

【図22】従来の光ヘッド装置の構成を示す図である。

【図23】従来の光ヘッド装置に用いるホログラム光学 素子の平面図である。

【図24】従来の光ヘッド装置に用いるホログラム光学 素子の断面図である。

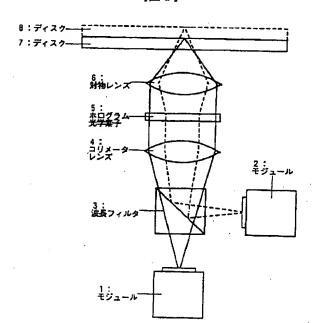
- 30 【符号の説明】
  - 1、2 モジュール
  - 3 波長フィルタ
  - 4 コリメータレンズ
  - 5 ホログラム光学素子
  - 6 対物レンズ
  - 7、8 ディスク
  - 9 ガラス基板
  - 10 SiO,
  - 11~13 領域
- 40 14 ガラス基板
  - 15~17 領域
  - 18 ホログラム光学素子
  - 19 対物レンズ
  - 20 ガラス基板
  - 21 SiO,
  - 22~24 領域
  - 25 ガラス基板
  - 26~28 領域
  - 29 波長フィルタ膜

20

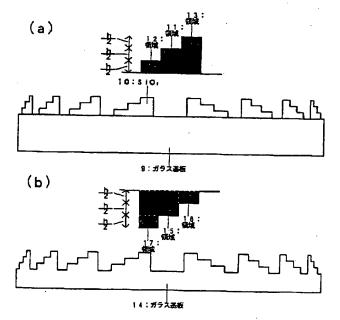
- 31、32 入射光
- 33 波長フィルタ
- 34~36 誘電体多層膜
- 37 半導体レーザ
- 38 光検出器
- 39 パッケージ
- 40 回折格子
- 41 ホログラム光学素子
- 42 スペーサ
- 43 ヒートシンク
- 44 ミラー
- 4.5 領域
- 46~55 受光部
- 56~61 光スポット
- 62 半導体レーザ
- 63 光検出器
- 64 パッケージ
- 65 偏光性ホログラム光学素子
- 66 1/4波長板
- 67 ニオブ酸リチウム基板
- 68 プロトン交換領域
- 69 位相補償膜
- 70~73 領域
- 74 光学軸
- 75~82 受光部
- 83~90 光スポット
- 91 半導体レーザ

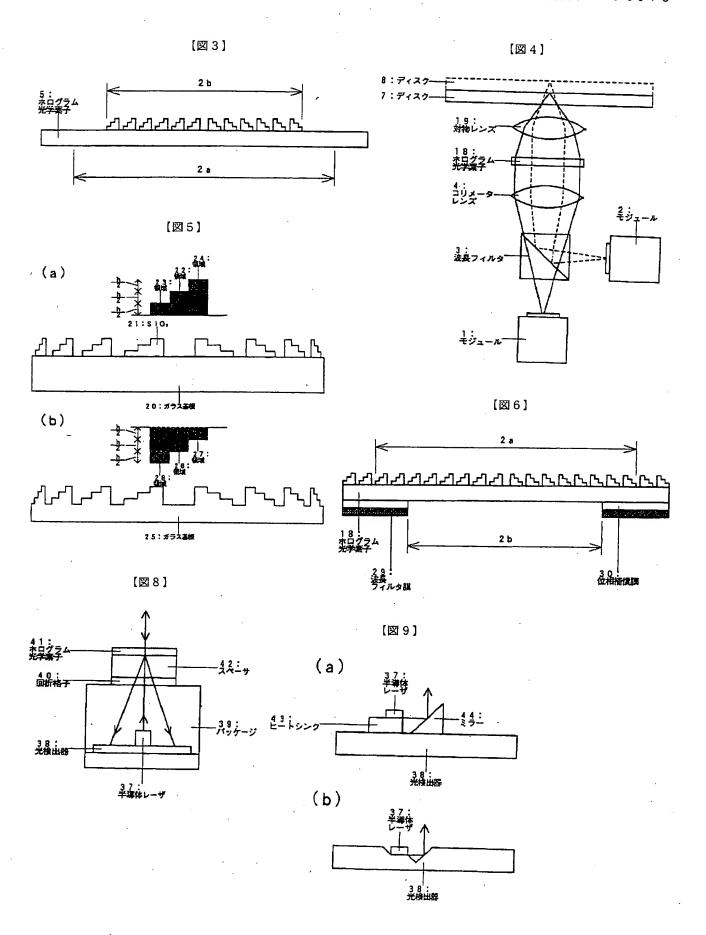
- 92 光検出器
- 93、94 マイクロプリズム
- 95 パッケージ
- 96 偏光性回折格子
- 97 ホログラム光学素子
- 98 スペーサ
- 99 光学軸
- 100~103 領域
- 104 入射光
- 10 105 透過光
  - 106 反射光
  - 107、108 誘電体多層膜
  - 109~122 受光部
  - 123~134 光スポット
  - 135 半導体レーザ
  - 136 モジュール
  - 137 波長フィルタ
  - 138 1/4波長板
  - 139 モジュール
- 20 140 半導体レーザ
  - 141 波長フィルタ
  - 142 1/4波長板
  - 143 半導体レーザ
  - 144 ハーフミラー
  - 145 ホログラム光学素子
  - 146 凹レンズ
  - 147 光検出器

[図1]

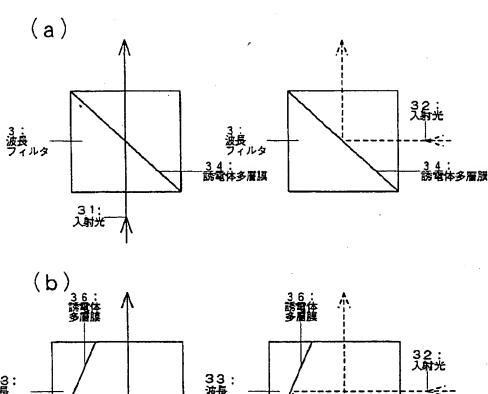


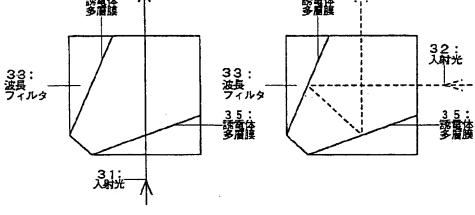
[図2]



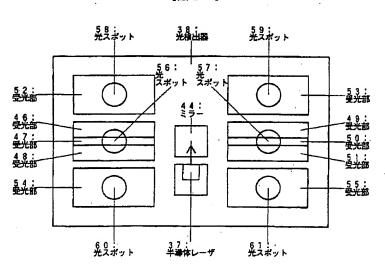


[図7]

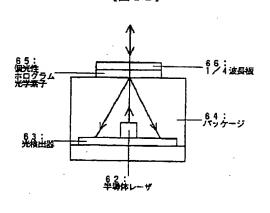


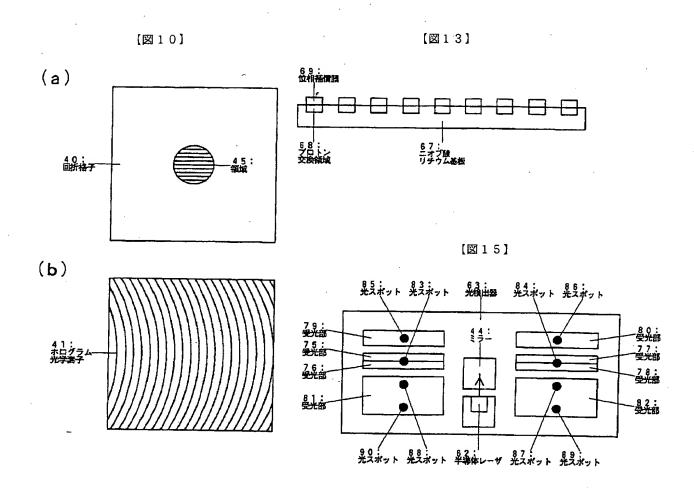


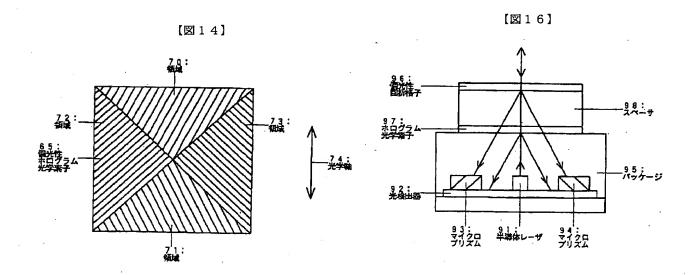
【図11】



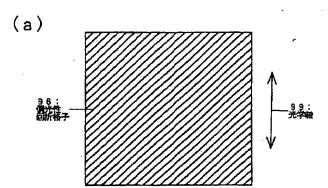
【図12】

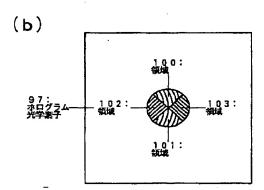




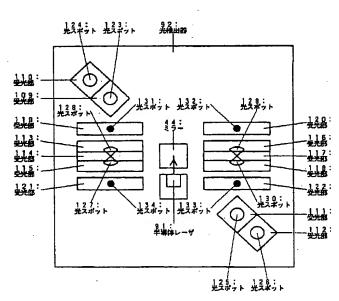


[図17]

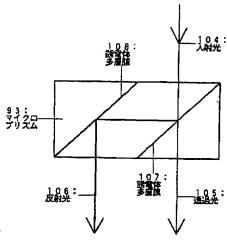




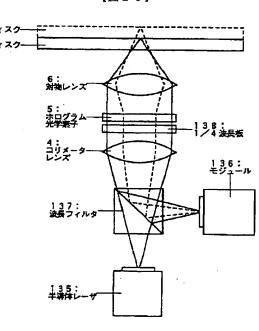
【図19】



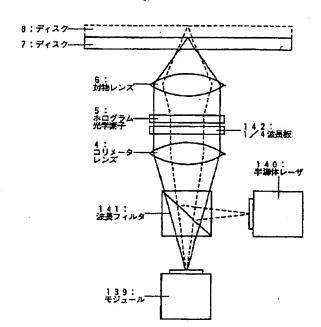
### [図18]



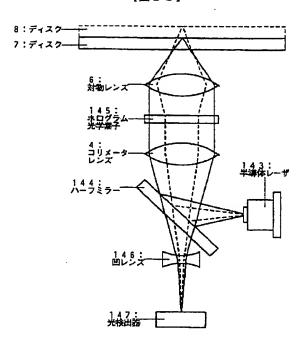
[図20]



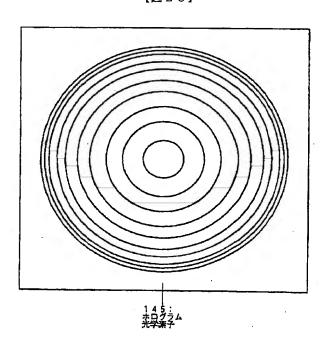
【図21】



[図22]

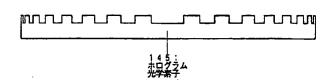


[図23]



[図24]

(a)



(b)

